Shantou Huashan Electronic Devices Co.,Ltd.

NPN SILICON TRANSISTOR

HC4242

APPLICATIONS

High Speed Switching And Power Amplifier.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS（T_a=25℃）

T_{stg}——Storage Temperature…… -55~150℃

T_j——Junction Temperature……150℃

P_C——Collector Dissipation（Tc=25℃）……40W

V_{CBO}——Collector-Base Voltage……450V

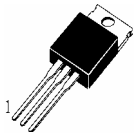
V_{CEO}——Collector-Emitter Voltage……400V

V_{EBO}——Emitter-Base Voltage……10V

I_C——Collector Current……7A

Ib——Base Current……2A

TO-220



1－Base，B
2－Collector，C
3－Emitter，E

ELECTRICAL CHARACTERISTICS（T_a=25℃）

Symbol	Characteristics	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
BVCBO	Collector-Base Breakdown Voltage	450			V	I_C=1mA, I_E=0
BVCEO	Collector-Emitter Breakdown Voltage	400			V	I_C=100mA, I_B=0
BVEBO	Emitter-Base Breakdown Voltage	10			V	I_E=1mA，I_C=0
ICBO	Collector Cut-off Current			100	μA	V_{CB}=450V, I_E=0
IEBO	Emitter Cut-off Current			100	μA	V_{EB}=10V, I_C=0
HFE（1）	DC Current Gain	15		55		V_{CE}=5V, I_C=0.8A
HFE（2）		10				V_{CE}=5V, I_C=2A
HFE（3）		10				V_{CE}=5V, I_C=4A
VCE(sat)	Collector- Emitter Saturation Voltage			0.8	V	I_C=4A, I_B=0.8A
VBE(sat)	Base-Emitter Saturation Voltage			1.2	V	I_C=4A, I_B=0.8A

hFE Classification

A	B1	B2	B3	B4
15—28	22—35	29—42	36—49	43—55